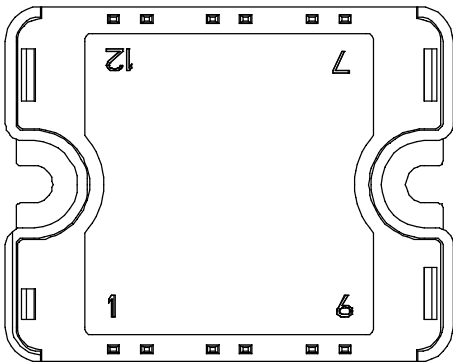
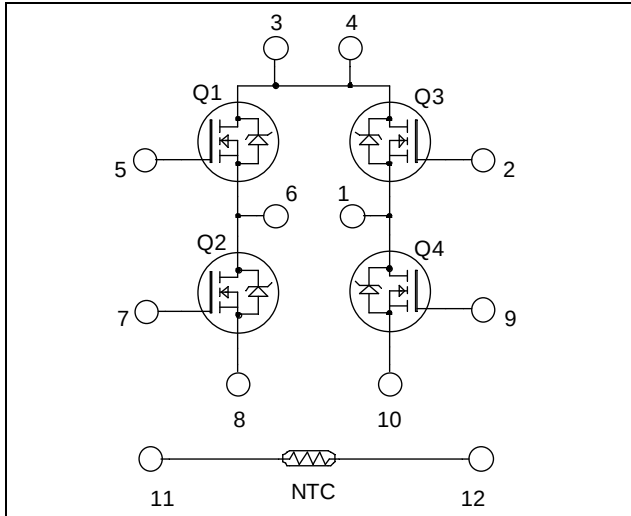


Full - Bridge MOSFET Power Module

$V_{DSS} = 1200V$

$R_{DSon} = 1.4\Omega \text{ typ @ } T_j = 25^\circ C$

$I_D = 8A \text{ @ } T_c = 25^\circ C$



Pins 3/4 must be shorted together

Application

- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies
- Motor control

Features

- Power MOS 8™ Fast FREDFETs
 - Low R_{DSon}
 - Low input and Miller capacitance
 - Low gate charge
 - Fast intrinsic reverse diode
 - Avalanche energy rated
 - Very rugged
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
- Internal thermistor for temperature monitoring
- High level of integration

Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Solderable terminals both for power and signal for easy PCB mounting
- Low profile
- Each leg can be easily paralleled to achieve a phase leg of twice the current capability
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{DSS}	Drain - Source Breakdown Voltage	1200	V
I_D	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$ 8	A
		$T_c = 80^\circ C$ 6	
I_{DM}	Pulsed Drain current	50	
V_{GS}	Gate - Source Voltage	± 30	V
R_{DSon}	Drain - Source ON Resistance	1.68	Ω
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$ 208	W
I_{AR}	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	7	A



CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 1200\text{V}$ $V_{GS} = 0\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		250	μA
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		1000	
$R_{DS(on)}$	Drain – Source on Resistance	$V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 7\text{A}$		1.4	1.68	Ω
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1\text{mA}$	3	4	5	V
I_{GSS}	Gate – Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30\text{V}$			± 100	nA

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0\text{V}$		3812		pF
C_{oss}	Output Capacitance	$V_{DS} = 25\text{V}$		350		
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1\text{MHz}$		44		
Q_g	Total gate Charge	$V_{GS} = 10\text{V}$		145		nC
Q_{gs}	Gate – Source Charge	$V_{Bus} = 600\text{V}$		24		
Q_{gd}	Gate – Drain Charge	$I_D = 7\text{A}$		70		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Resistive switching @ 25°C $V_{GS} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 800\text{V}$ $I_D = 7\text{A}$ $R_G = 4.7\Omega$		26		ns
T_r	Rise Time			15		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			85		
T_f	Fall Time			24		

Source - Drain diode ratings and characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_S	Continuous Source current (Body diode)	$T_c = 25^\circ\text{C}$			8	A
		$T_c = 80^\circ\text{C}$			6	
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0\text{V}$, $I_S = -7\text{A}$			1	V
dv/dt	Peak Diode Recovery ❶				25	V/ns
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_S = -7\text{A}$ $V_R = 100\text{V}$ $di_S/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		250	ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		520	
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$	1.12		μC
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	3.03		

❶ dv/dt numbers reflect the limitations of the circuit rather than the device itself.

$I_S \leq -7\text{A}$ $di/dt \leq 1000\text{A}/\mu\text{s}$ $V_{DD} \leq 800\text{V}$ $T_j \leq 125^\circ\text{C}$

Thermal and package characteristics

Symbol	Characteristic			Min	Typ	Max	Unit
R _{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance					0.6	°C/W
V _{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t =1 min, I isol<1mA, 50/60Hz			2500			V
T _J	Operating junction temperature range			-40		150	°C
T _{STG}	Storage Temperature Range			-40		125	
T _C	Operating Case Temperature			-40		100	
Torque	Mounting torque	To heatsink	M4	2.5		4.7	N.m
Wt	Package Weight					80	g

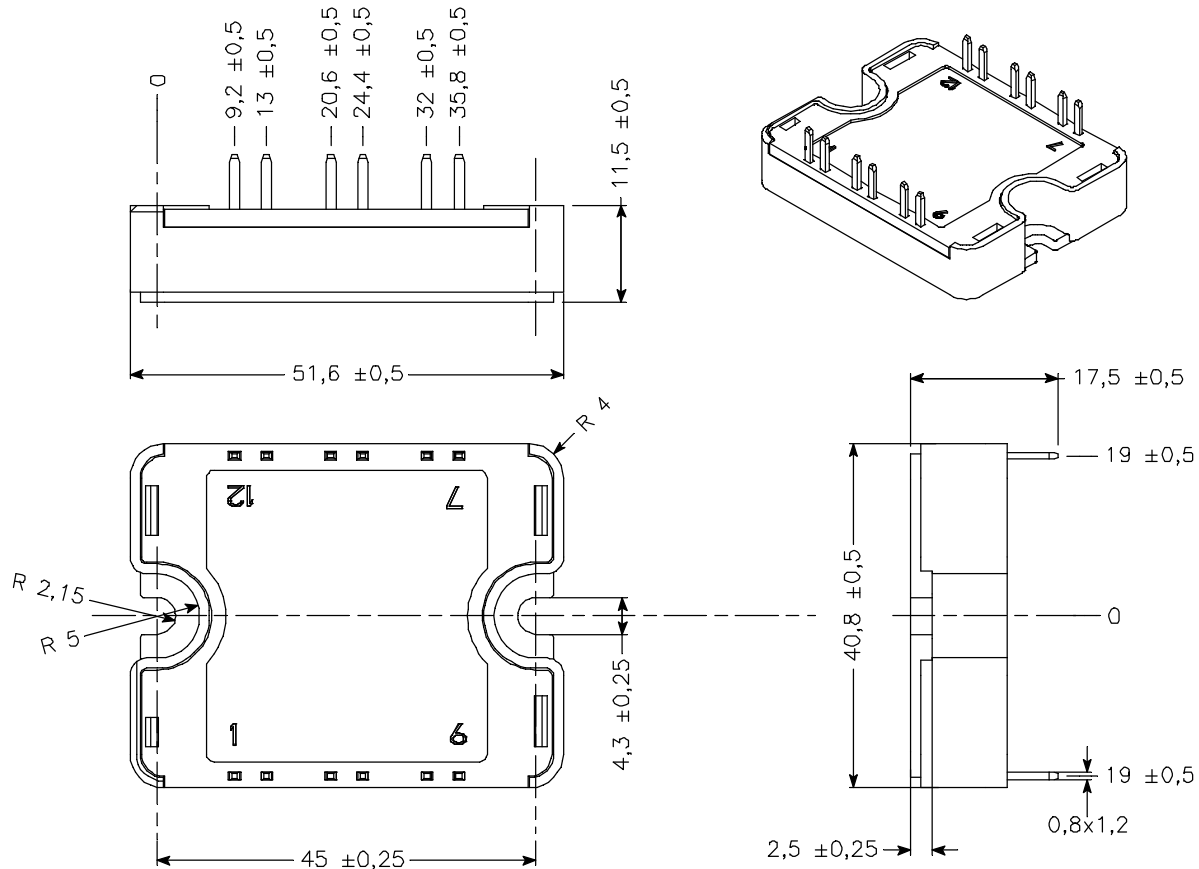
Temperature sensor NTC (see application note APT0406 on www.microsemi.com for more information).

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R_{25}	Resistance @ 25°C		50		kΩ
$B_{25/85}$	$T_{25} = 298.15$ K		3952		K

$$R_T = \frac{R_{25}}{\exp \left[B_{25/85} \left(\frac{1}{T_{25}} - \frac{1}{T} \right) \right]}$$

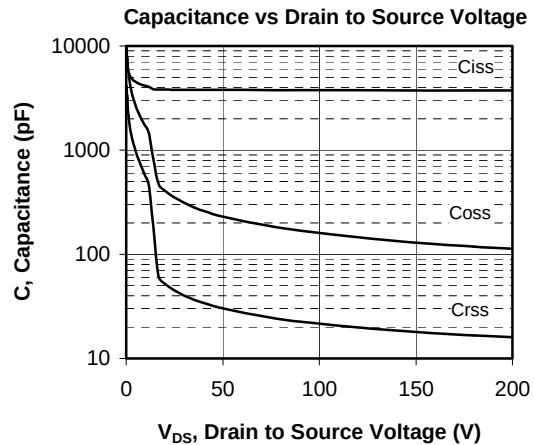
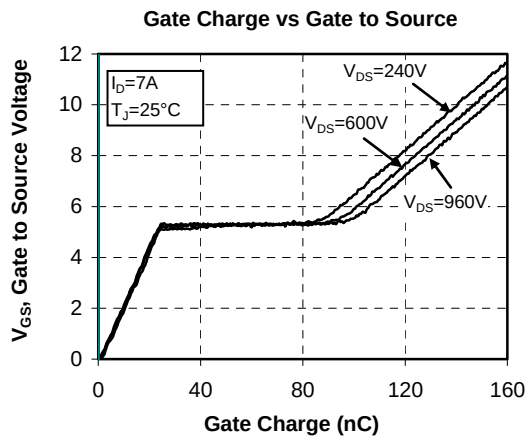
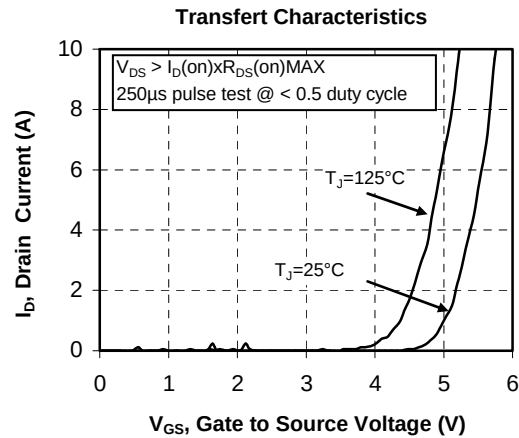
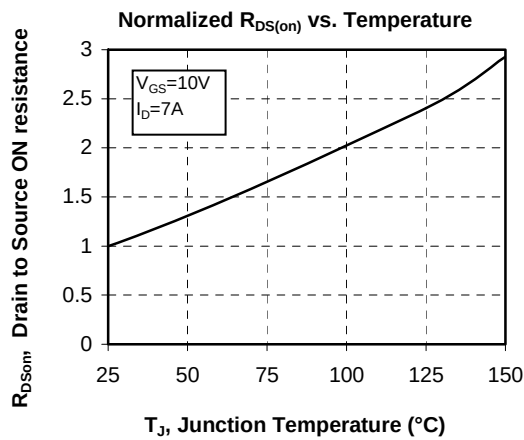
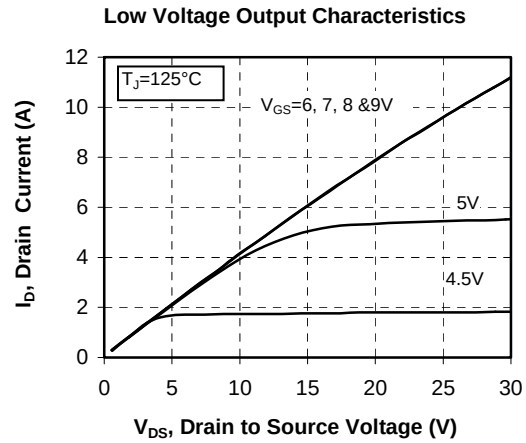
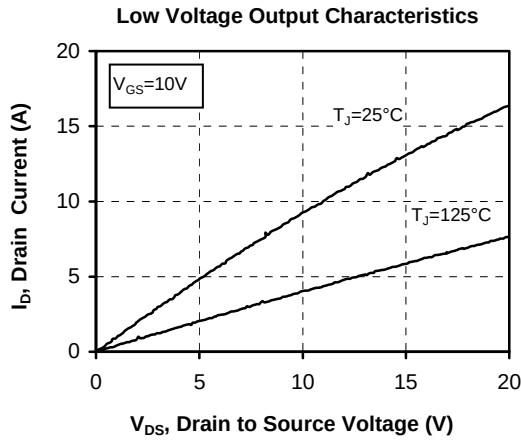
T: Thermistor temperature
 R_T : Thermistor value at T

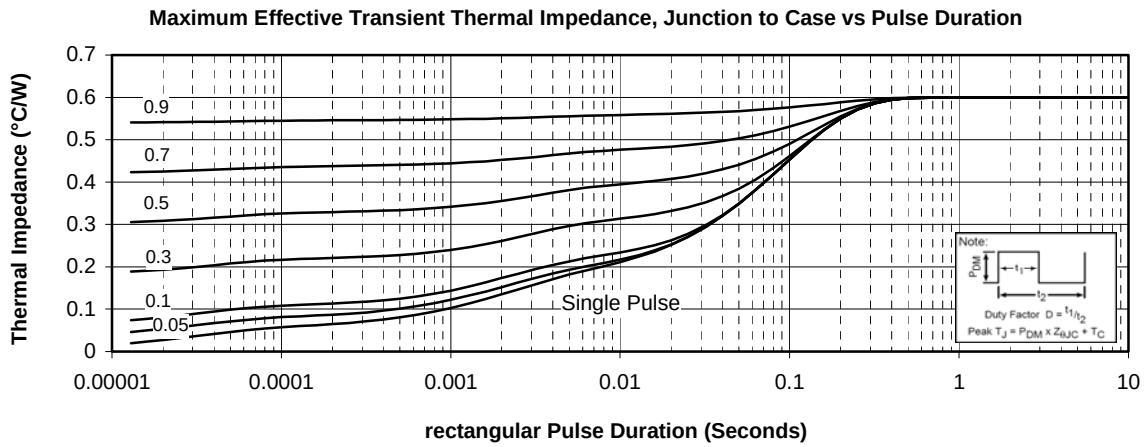
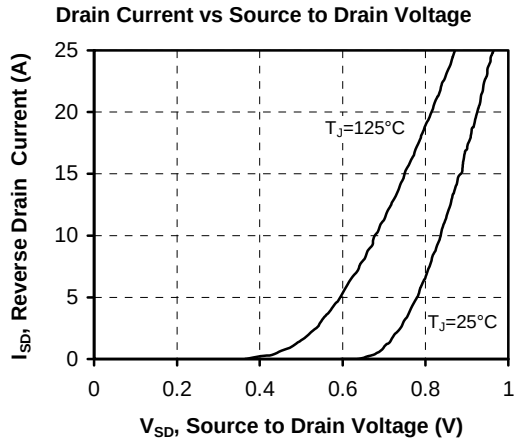
SP1 Package outline (dimensions in mm)



See application note 1904 - Mounting Instructions for SP1 Power Modules on www.microsemi.com

Typical Performance Curve





Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331